

# 半导体优选电路手册

中国科学院  
电子学研究所



R72.67273  
122

# 半导体优选电路手册

(PSC 1—22)



## 譯者的話

随着我国无线电工业的发展，无线电设备的半导体化愈来愈显得重要了。为了方便无线电工作者使用半导体器件，我们将美国海军部所编的海军空用的半导体优选电路手册 (Handbook of Preferred Semiconductor Device Circuits) 譯出。这本手册中包括无线电设备应用的主要半导体电路(其补充部分准备另行出版)，有稳压电源、电子门电路、多谐振荡器、脉冲放大器、视频放大器和发射极输出器等。这些电路对我们进行标准化方面很有参考意义。

由于译者水平所限，译文中错误在所难免，希望读者多提宝贵意见。

## 原 文 前 言

这本“优选电路手册”的目的在于将已論証的电子电路編成文件并促进它們在海军空用电子设备的设计中的应用。

现代技术的发展已使之可能生产多种用途的、可靠的和小型化的电子设备，其可能达到的程度是几年前所不能想到的。使用“优选电路手册”就是为了达到上述的目的。此外，由于更有效地使用技术人员力量、更迅速地分析电路缺陷和用更少的培训计划、较短的研究与试制时间以及在不牺牲优良设计的情况下有较低的造价而可以做到节约。

这种优选电路汇编的最后的成绩是要取决于设计工程师和设备制造厂方积极地参与对此电路的使用、对本手册内所提供的资料提出意见并提供一些改进的和补充的电路列入本手册内。



## 原序

电路标准化的重要性是由于采用机械化生产日益增多和电子设备生产自动化的前景所引起的，而且也是因为相信电子设备的可靠性可以因采用在战场上验证过的电路设计而得到改进。电路标准化的其他的优点是：在电子设备的设计、试制、生产和维护上可以更有效地使用技术人员力量；在设备及备件的生产和购置上可以节约；另外，还可以改进备件的分配。

初步研究证明，很大部分的电路功用可以进行标准化而对设备的性能没有什么不利的影响。随着电子管电路选择和试验的计划拟订后，在1955年9月出版了最初的“优选电路手册”。这本手册中的电路是以很多商业和军用电子设备的试验性测试以及有代表性并被公认的电路为基础汇编而成的。差不多在所有情况下，类似的电路在过去用了至少有十年之久而只有很小的改进。在出版这本手册后，一些符合这些相同条件的其他电子管电路则附在出版的补充文件内。

由于出版的电子管优选电路手册的成功和得到良好的公认就导致开始对晶体管电路作了相似的出版计划。但是优选的晶体管电路尚不能建立在对现有的半导体装置大量选样的基础上，因为仅有很少的晶体管化设备在战场上广泛地使用。另外，晶体管电路是经常处在改进中，从而优选晶体管电路预计也可能会变成陈旧的而且比之电子管电路更经常地需要更换。虽则如此，对优选电子管电路归纳的一些优点同样也适用于优选晶体管电路。

最初，晶体管优选电路汇编是作为电子管优选电路计划的补充部分，因此两者是一块出版的，但晶体管部分编号以PC 201开始来使它们分开。1959年，晶体管的汇编扩大了而且将之与电子管部分分开。结果，修定过后的“优选电路手册”分为两部分出版，即第一册的“电子管优选电路”和第二册的“半导体器件优选电路”。

由于半导体电路目前是用单独的手册形式出版的，电路的编号就没有必要再从201开始。电路的编号也已改成顺序排列而不是在最初出版的手册内所用的分组排列(block system)。这本半导体优选电路手册用的编号是从PSC 1到PSC 22，至于补充部分将以PSC 23作为第一号，将来增添的电路将依次連續编下去。为了将这些晶体管电路和有相同号数的电子管电路区分开来，又由于感到将来要编入这本手册是半导体电路而不是晶体管电路，所以这些电路的名称就给改成“优选半导体电路”，名称缩写为PSC。

在选择优选电路时，我们首先给予考虑的是那些适用于不同类型电子设备的、设计成熟的电路。对优选电路的选择和设计，我们采用下列一般原则：

- (1) 电路必须是个起作用的单元，不管有多少晶体管和其他半导体器件。
- (2) 电路应该显示与妥当和稳定的設計相一致的最好性能。
- (3) 电路必须根据军用标准所包括的元件型号进行选择。随便在什么地方都应采用可能的优选元件和数值。特别是晶体三极管和二极管必须根据列在“晶体管优选指南表”(军用标准MIL-STD-701)中的器件进行选择，在出版半导体电路时此军用标准须是有效的。
- (4) 电路必须设计成能用列在军用标准内的元件类型中的任何元件来按规定进行工作。另外此电路内必须包括足够的衰落和补偿范围，以便一些精密元件在已达到其寿命结束的极限时能得到所规定的性能。
- (5) 当需要用稳压电源时，必须采用军用标准MIL-STD-706 A (“电子设备用的电源电压”)中所规定的电压。

(6) 电路間的互作用必須用下列方法減至最小：在电路間提供足够的去耦或提供优选电  
路所带来的瞬变和它所承受的瞬变方面的資料，以便能設計有效的去耦电路。

本手册內的这些优选电路是作为目前設計工作的一种指导和判断設計工作改进的一种根  
据。我們希望工程师們将这本“优选电路手册”作为电路設計水平的合宜的总结并作为避免設  
計上不必要的多样性和人力浪費的一种方法。

## 优选电路手册的汇编情况和使用說明

优选电路手册的第二册的目的是給那些熟悉半导体电路，但对所考虑的电路类型还未能有詳細了解的工程师們作为一种設計工具。假定使用这本手册的人是在寻求一种特定用途的作用电路。这本手册的目的就是要提出这样一种电路，說明它的各項性能，使有預見性的使用者能确定这种电路是否合乎其需要并提供这种电路的設計資料。

手册内每一个优选电路都包括电路图解和它的規范并有叙述这种电路的用途、設計和性能等的正文部分。

在大多数的情况下，优选电路的图解和附带的規规范将提供足够的資料来确定优选电路是否具有規定用途中所需的性能。其元件值一般是列在电路图上。当必須对元件值加以选择来滿足工作条件时，一般是采用公式的形式在規规范表內說明了选择的元件值。規规范表內还提供了元件补充的資料、电路的工作性能及其功率要求。

另外，在規规范表內列出了电阻上耗散的功率、电容的耐压强度（能在电路图上看出的除外）以及电阻和电容的极限值以帮助对元件的选择。本优选电路內所用的“极限”一詞是包括元件的起始公差和环境改变、老化和其他原因而引起的偏移。这本手册內所規定的电路性能是假設其元件值在电路工作时仍保持在所述的极限内。电阻耗散值和电容电压值考虑了元件和电源电压在所規定的极限内的变化。

規规范表中“工作特性”一項尽量規定得全面些，其形式是随着电路的类型而改变。这方面資料在正文的“性能”部分作了补充。

“功率要求”一項包括电源电压、对它們必须稳压的程度和每个电源电压所要求的电流。

在正文部分，开头的“用途”一項列述了优选电路的典型用途，而且還可能包括一些补充資料，例如这种优选电路和其他类似电路的比較，这种电路的不利性能或其应用的局限性。通过參閱优选电路的图解、規规范表和用途部分，一个有預見的使用者應該能确定这种电路是否合乎他的需要。

在正文部分，“設計中考慮的問題”一項的目的是对选择还不够清楚的电路說明其設計的选择并提供恰当的設計資料。这部分包括数值选择的标准，以及在选择元件上需要注意的一些事項。一般在这一項內是不述及机械结构細节，但在必要的地方还是包括了机械结构所需的注意事項。这一項內不包括理論性的探討，除了需要对其他的設計問題进行討論的地方以外。

正文部分內第三个主要項目是“电路性能”一項，在這項里电路的性能要比数据說明部分內談論得多。对电路所規定的性能是以“最坏情况”的設計为依据，但却很詳細地談論到要求严格的元件和电源电压的变化影响以便使采用統計方法的設計師将之作为确定元件特性和电源电压变化的相对影响的基础。由于电子电路并不是理想的基本单元，仍然受到它前面和后面电路的影响，故本手册內也論及到負載、电源阻抗和电源瞬变的影响。

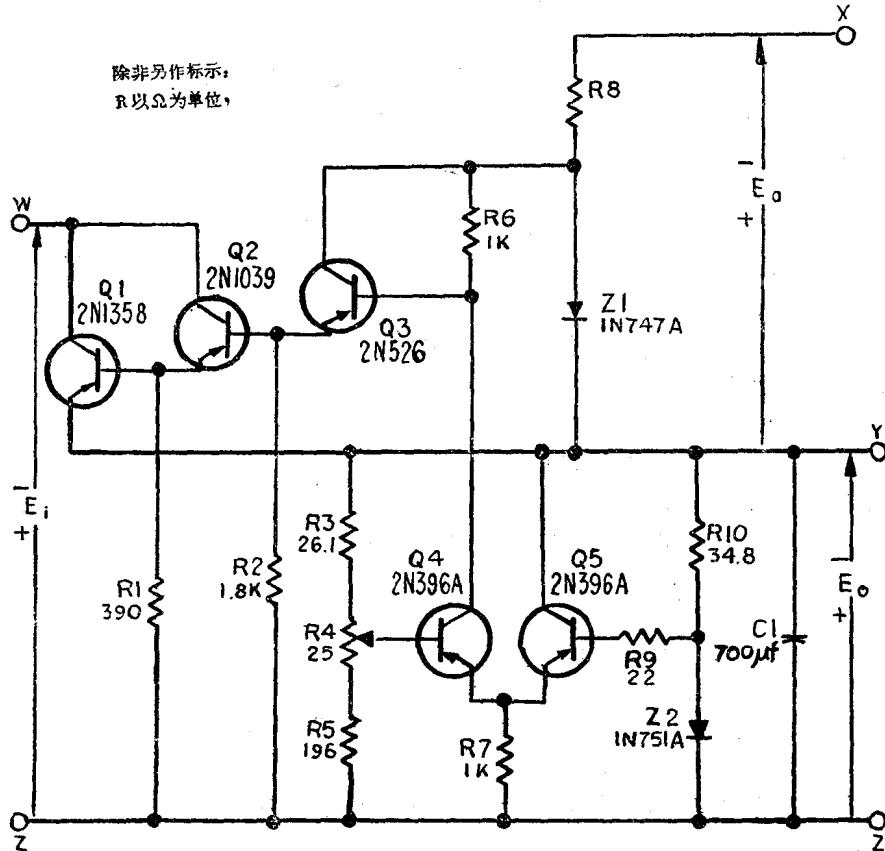
所有的半导体优选电路都有着以上所述的主要部分，在需要的时候还可能加进其他的分項，例如在 PSC 9 就增加了“使用的实例”一項。

1109/20-02

## 目 录

譯者的話	( i )
原文前言	( i )
原序	( ii )
优选电路手册的汇編情况和使用說明	( iv )
PSC 1 正或負 6 伏直流稳压器; 1% 稳压度	( 1 )
PSC 2 正或負 12 伏直流稳压器; 1% 稳压度	( 15 )
PSC 3 正或負 25 伏直流稳压器; 1% 稳压度	( 26 )
PSC 4 正或負 50 伏直流稳压器; 1% 稳压度	( 38 )
PSC 5 正或負 100 伏直流稳压器; 1% 稳压度	( 49 )
PSC 6 7 千伏阴极射綫管电源	( 60 )
PSC 7 2 个和 4 个輸入端的一般用途“与-或”門	( 66 )
PSC 8 2 个和 4 个輸入端的脉冲“与-或”門	( 73 )
PSC 9 150 周双稳态多諧振蕩器	( 78 )
PSC 10 单稳态多諧振蕩器	( 88 )
PSC 11 脉冲形成电路	( 95 )
PSC 12 脉冲功率放大器	( 101 )
PSC 13 指示器	( 108 )
PSC 14 饱和的双稳态多諧振蕩器	( 110 )
PSC 15 非饱和的双稳态多諧振蕩器	( 117 )
PSC 16 多諧振蕩器可变門脉冲发生器	( 122 )
PSC 17 继电器控制多諧振蕩器	( 128 )
PSC 18 低电平視頻放大器	( 131 )
PSC 19 中等电平視頻放大器	( 138 )
PSC 20 高电平視頻放大器	( 144 )
PSC 21 脉冲发射极輸出器	( 152 )
PSC 22 补充对称发射极輸出器	( 157 )

# 半导体优选电路 PSCI. 士 6 伏直流稳压器 (1% 稳压度)



## 图注:

- (A) 任一输出端都可接地, 但负输入端 W 必须不接地。
- (B) 辅助电源  $E_a$ , 可以对正输出端 Z 成回路, 而不是对负端 Y 成回路, 如图所示。如对不接地的输出端成回路, 则需采用一浮动的辅助电源。可参看 2.5 节。
- (C) 晶体管 Q1 和 Q2 必须装在一个散热器上, Q3 应采用一个紧夹的散热器以增加可靠性。可参看 2.6 节。
- (D) 沿着正与负输出电压汇流条, 接触电阻和导线电阻应保持为最小值。可参看 2.9 节。

## 元件:

**R3、R5:** 由于环境改变而产生的 R3 对 R5 之比的百分变化必须小于  $\pm 1\%$  以达到所规定的输出稳压度。每个电阻的起始公差可为  $\pm 1\%$ 。功率消耗额定值必须是稳定的而且选择使两个电阻的每欧姆瓦数值接近相等。

**R4:** 由于环境改变而产生的百分变化值必须小于  $\pm 5\%$  以达到所规定的输出稳压度。起始公差可为  $\pm 10\%$ 。

**R8:** 电阻和功率消耗决定于辅助电源电压和辅助电流的极限值。可参看 2.5 节。

*C 1:* 此电容可并联几个較小的单元而得之。为了在低温时可靠地工作需用一鉭电容器。在 25°C 时电容应不小于 650  $\mu$ F。在 -55°C 时视在电容的下降应不小于 50%，而串联电阻的增长应不少于 10 倍。

最大功率耗散 (注 1): *R 1:* 170 mW; *R 2, R 10:* 50 mW; *R 3, R 4, R 6:* 20 mW; *R 5:* 130 mW; *R 7:* 30 mW; *R 8:* 見上; *R 9:* <10 mW。

极限值 (这并非公差; 見注 2): *R 1, R 2, R 9:*  $\pm 20\%$ ; *R 3, R 4, R 5, R 8:* 見上; *R 6, R 7:*  $\pm 5\%$ ; *R 10:*  $\pm 2\%$ 。

### 功率要求:

由未經稳压的电源取得的輸入:

电压 *E<sub>i</sub>*: 最小值为 7.1 伏。最大值为散热器热阻、最大負載电流以及在特定应用时的最高工作溫度的函数 (参看 2.6 节和图 1—4)。最大絕對值为 50 伏 (注 3)。

电流 *I<sub>i</sub>*: 最大值为 4.2 安培。

輔助电源:

电压 *E<sub>a</sub>*: 最小值为 5 伏(注 4)。最大值不受限制。此电压可不經稳压。

电流 *I<sub>a</sub>*: 最小值为 35 ma。最大值为 75 ma (极限决定于 *Z1* 并由 *R 8* 的正确选择来控制。参看 2.5 节)。

### 工作特性:

溫度范围: -55°C 至 +65°C (参看 2.6 节和图 1—4)

輸出电压: 6 伏, 正或負。

輸出电流: 0 至 4 安培 (参看 2.6 节和图 1—4)。

总的稳态稳压度加上稳定性 (参看 3.1 节):  $\pm 1\%$ 。

輸入电压在 7.1 和 11.1 伏之間变化的稳压度:  $\pm 0.1\%$ 。

負荷电流在 0 和 4 安培之間变化的稳压度:  $\pm 0.3\%$ 。

辅助电源电流在 35 和 75 ma 之間变化的稳压度:  $\pm 0.2\%$ 。

溫度稳定性: 每度(°C)为  $\pm 0.005\%$ 。

时间稳定性 (8 小时的时间):  $\pm 0.05\%$ 。

瞬态稳压度 (参看 3.2 节):

对輸入电压变化的稳压度: 25°C 时为  $\pm 1\%$ , -40°C 时为  $\pm 4\%$ , -55°C 时为  $\pm 6\%$ 。(在 0.02 微秒時間內輸入电压在 7.1 和 11.1 伏之間变化。)

对負載电流变化的稳压度: 25°C 时为  $\pm 2\%$ , -40°C 时为  $\pm 10\%$ , -55°C 时为  $\pm 20\%$ 。(在 1.0 微秒時間內負載电流在 0 和 4 安培之間变化。)

瞬态恢复时间 (参看 3.2 节):

在輸入电压变化之后: 50 微秒。

在負載电流变化之后: 25°C 时为 200 微秒 (恢复时间将随溫度而增长, 在滿載到无载的突变下, 当溫度为 65°C 时达到 2 毫秒的最高值)。

輸入脉动降低系数(注 5): >1000。

25°C 时的輸出阻抗: <0.05 欧(直流至 10 KC), <0.1 欧(10 KC 至 300 KC)。

### 附注:

1. 这是在电阻上耗散的最大功率, 在确定这些值时, 对元件值、电源电压 和晶体管特性的变化已作考虑。

2. 性能规范是以元件值与标称值的公差不超过所規定的量为依据。对于本文所列的元件, 重要的仅是对元件标称值的总偏差。因此規定的最大偏差称为“极限值”, 它包括起始公差加上环境变化或老化而引起的漂移。

3. 大于 50 伏的电压, 即使是瞬时的, 也可以使 *Q1* 或 *Q2* 产生电压击穿。

4. 如果輔助电源对正端 *Z* 成回路, 則这个最小值将为 11 伏。

5. 輸入脉动降低系数为: 在 0 与 800 赫之間任一脉动频率时, 輸入电压內出現的交流脉动与輸出电压內出現的最終交流脉动之比。

# PSCI ± 6 伏直流稳压器 (1% 稳压度)

## 1. 用途

PSCI 是用一个未經稳压的直流电源来提供一个对电源电压、負載电流和环境条件(特别是溫度) 的变化进行过稳压的电源电压。脉动降低和低輸出阻抗作为上述要求的附带条件。PSCI 在 6 伏时所提供的电流将达 4 安培，因而是設計用于要求电源电压变化 小于 1% 以及稳压元件功率消耗低的情况。

所規定的 1% 稳压度包括随着时间(达八小时的时间) 和环境变化的輸出电压穩定度；但并不包括由于輸入电压或負載电流大的突变而引起的为时极短的輸出电压瞬变。輸入电压突变的瞬态稳压度是从 1% 变到 6%，負載突变的稳压度是从 2% 变到 20%，这是决定于最小的工作溫度。輸入电压突变的瞬态持續時間将不超过 50 微秒，而負載电流突变的瞬态持續時間将不超过 200 微秒。

为了简单和有效起見，PSCI 內并不包括过載和短路的保护設施。但如要求这方面特性的話則可将之加进本电路內<sup>①</sup>，或者在外部用继电器控制的方法来滿足。

## 2. 設計中考慮的問題

### 2.1 基本稳压器电路

PSCI 是一个采用負反饋控制輸出电压的串联稳压器(控制元件与負載串联)。这类稳压器(关于其基本設計已在文献<sup>②</sup> 中論述) 在半导体誕生以前，不太适用于低压高电流的情况。在参与竞争的稳压器类型中，并联稳压器(控制元件与負載并联)可提供較好的稳压度但对于同样范围的輸入电压和負荷电流具有較低的效率。磁性放大器式稳压器一般具有优越的效率，但体积較大而且瞬态特性較差。此外，后者的設計还須考慮到未經稳压的电源問題，即功率变压器、滤波器等問題。而串联稳压器可以設計成是采用任何电源来进行工作，只要电源提供的輸入在規定的极限以內。

图 1—1 中示出了一个基本串联稳压器的方块图。利用选样电路可以使稳压过的輸出对稳定的標準有恒定的比較。輸出电压的任何变化用比較电路来检验，然后进行放大再回加至串联的控制元件，就用这种方法改变其电阻以阻止輸出电压原来的变化。PSCI 內的晶体管 Q 1 为串联控制元件；Q 2 和 Q 3 系将电压放大器的輸出阻抗和串联控制元件的輸入阻抗进行匹配的发射极輸出器；Q 4 和 Q 5 組合为一个差动放大器，它构成比較电路和扩大反饋电路的电压放大倍数；R 3、R 4 和 R 5 組成选样电路；稳压二极管 Z 2 則为標準元件。

### 2.2 詳細的电路工作

当輸入电压或負載电流起变化时，加到串联晶体管 Q 1 基极的可变輸入信号改变它的集电极-发射极电阻以稳定輸出电压。为了了解电路在补偿輸出电压变化时的作用，假設負載

① 可參看 C. A. Franklin P. M. Thompson 以及 W. M. Caton 合著的“Precision High-Voltage Transistor-Operated Power Regulators With Overload Protection”，The Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, Volume 106, Part B, Supplement № 16, May, 1959, pp. 714—725.

② R. D. Middlebrook, “晶体管稳压电源的設計”，Proceeding of the IRE. Volume 45, Number 11, November, 1957, pp. 1502—1509.

电流不变，输入电压  $E_i$  增大。一开始加到  $Q_1$  基极的输入信号没变化，它的集电极-发射极电阻也不会变化，而输出电压  $E_o$  则有随着输入电压而上升的趋势。输出电压的一部分，也就是它的增加的一部分通过分压器  $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$  加到  $Q_4$  的基极上。晶体管  $Q_4$  和  $Q_5$  接成一个差动放大器，它对晶体管基极之间的任何电压差进行放大。由于稳压二极管  $Z_2$  使  $Q_5$  基极上的电压保持恒定， $Q_4$  则将它的基极升高的电压进行放大和倒相，并通过发射极输出器  $Q_2$  和  $Q_3$  加到  $Q_1$  的基极上作为电压降低。这个发射极输出器改进电压放大器  $Q_4$  集电极高输出阻抗和串联晶体管  $Q_1$  的基极低输入阻抗之间的匹配。 $Q_1$  基极电压的下降增大  $Q_1$  的集电极-发射极电阻，使得  $Q_1$  在已定的负载电流下，有较大的电压降。这样，当  $E_i$  上升时， $E_o$  基本上保持不变。但应注意，为了引起  $Q_1$  集电极-发射极电阻的变化， $E_o$  必须产生一些有限的变化。

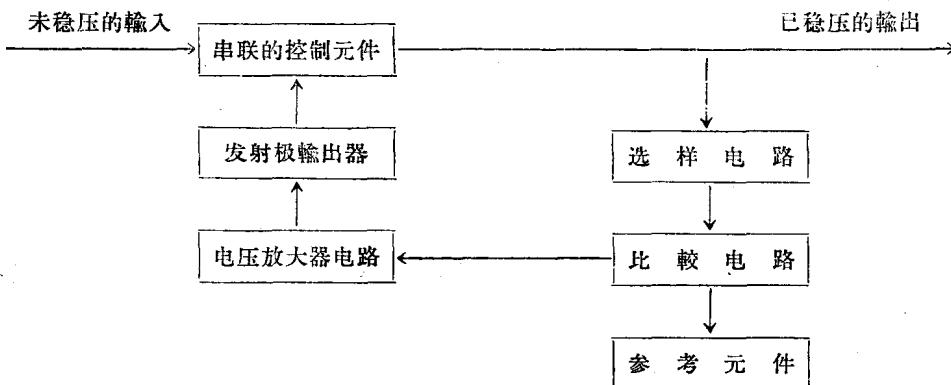


图 1-1 基本串联稳压器的方块图

为了了解电路在负载变化稳压时的作用，设输入电压保持不变，负载电流加大。一开始  $Q_1$  的集电极-发射极电阻并无变化，而输出电压  $E_o$ ，因为负载电流的加大使得  $Q_1$  的电压降增加，则有下降趋势。将输出电压减小的一部分加至  $Q_4$  的基极，由  $Q_4$  加以放大和倒相并通过发射极输出器作为电压增大加至  $Q_1$  的基极。 $Q_1$  基极电压的上升就减小  $Q_1$  集电极-发射极的电阻，在负载增大时保持  $Q_1$  上的电压降，因而也保持  $E_o$  基本上不变。和上面一样，为了引起  $Q_1$  集电极-发射极电阻的改变， $E_o$  必须产生一些有限的变化。

### 2.3 晶体三极管和二极管类型的选择

锗晶体三极管用得较普遍，这是由于它们目前在价格上优于类似的硅器件，而且它们有着较低的基极-发射极电压降。这种晶体三极管的最高工作温度虽低于硅器件可以达到的温度，但却仍然满足很多的用途。本电路规定用 PNP 型管，但类似的 NPN 型管如果加以使用或在使用时也同样可以用得很好，方法是将全部输入和输出端的极性倒置。在所用的四种类型的晶体三极管中有三种自 59 年 9 月就已经列入“晶体三极管和二极管军用优选指南表”（军用标准-701 B）内，每一种指标都说明这三种管型要继续采用。第四种管型 2N1358 是电性能等效的晶体三极管，它能代替军用标准 701 B 中的 2N174 型管。

选择 2N1358 型作串联控制元件，因为它有高功率耗散和比较大的电流放大系数。2N1039 和 2N526 型管分别满足发射极输出器  $Q_2$  和  $Q_3$  的功率、电压和电流放大系数的要求，在高温或过大尺寸时都不会有过大的  $I_{ce}$ 。但用于差动放大器  $Q_4$ ， $Q_5$  中的晶体三极管的兼备的要求也許最难达到。这里选用 2N396A 型管，由于它具有改进稳压管频率响应所

需要的相当高的截止频率；另外因为它有着相当大的功率耗散和电压额定值以及具有很低的最大  $I_{C0}$  额定值，这几点在温度升高时对稳压器的稳定性极为重要。

PSC 1 所用的两种稳压二极管型号都列在军用标准 701 B 中，并且可以从几个不同的来源加以采用。

## 2.4 稳压器的效率

串联控制元件上的电压降用了辅助电源  $E_a$  被减到最小。这样就减小串联元件的功率损耗，从而使稳压器得到最大的效率。

和负载串联连接并主要起着可变电阻作用的功率晶体三极管  $Q_1$  用作串联控制元件。 $Q_1$  上的电压降越低，则在规定的负载电流下在它上面消耗的功率就越小。串联控制元件内功率损耗较小，则表示输出功率对输入功率之比较高，从而稳压器的效率较好。但要求稳压器同时具有高效率和良好的稳压度是困难的，所以一般在设计上所采用的方法是牺牲效率。如用一辅助输入电源则可在不牺牲效率的条件下而具有良好的稳压度。这在下段加以说明。

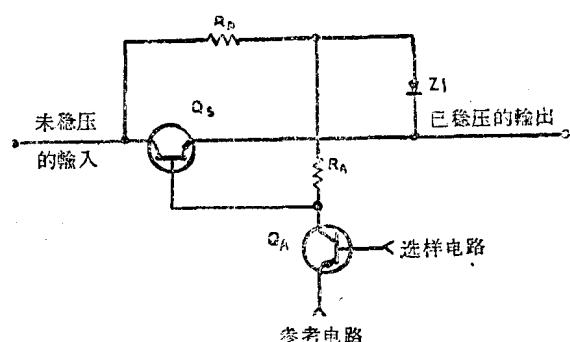
为了使串联稳压管具有最好的稳压性能，应将放大器负载电阻对一固定不变的电压成回路，这电压比串联晶体三极管③发射极电压稍微大一些。图 1-2 简化的图解表示了取得上述条件的一般方法。图中放大器负载电阻  $R_A$  对稳压二极管  $Z_1$  所稳定的电压成回路，这个稳定的电压比串联晶体三极管  $Q_s$  发射极的电压为高，所高的值等于  $Z_1$  的击穿电压。这种方法的缺点是：串联控制元件  $Q_s$  的电压降必须比稳压二极管的电压大，因为电压低了就不足以使二极管在其击穿区域内进行工作。此外，为了针对输入电压变化而得到最佳的稳压度和最大的输入脉动降低，电阻  $R_D$  与  $Z_1$  的动态阻抗相比必须要大。这样， $Z_1$  足够大的电流就会在  $R_D$  上产生大的电压降（当它加到  $Z_1$  的击穿电压时就在串联控制元件  $Q_s$  上产生一个最小的电压降），这电压降大得使稳压管的效率严重地降低。如用一辅助电源供给  $Z_1$  电流，就会在  $Q_s$  上的电压降小得多的时候得到最好的稳压性能。串联控制元件上的功率损耗也因之减小，从而改进了稳压器的效率。输入功率仅随辅助电源中的内损耗而增大，这是因为无论是否用辅助电源，都必须要将电压和电流供给  $Z_1$ 。

PSC 1 的串联控制元件上的电压降可以小至 1.1 伏。这个值是绝对最小电压降，因为任何比这更小的电压降会使  $Q_1$  对输出电压失去控制。反回到放大器负载电阻  $R_6$  上的恒定的电压比  $Q_1$  的发射极电压要大 3 至 4 伏，这是为了能在负载电流和环境温度的整个范围内给放大器  $Q_4$  提供足够大的工作范围。

本优选电路采用单个串联晶体三极管而不是二个或更多的并联晶体管。虽然用并联组合可以控制较大的负载电流，但由于电流平衡电阻（必须将它加入电路内和每个发射极串联）内消耗的功率会使稳压器的效率有所损失。除此之外，还需要用另外的发射极输送器来控制增大的控制电流。

## 2.5 对辅助电源 $E_a$ 的要求

辅助电源可以是经过稳压的或未经稳压的。只要辅助电源的电流可以用选择  $R_8$  的方法保持在规定的 35 至 75 毫安的极限内，则标称电压和稳压度可留给使用方来选择。最小的



輔助电源电流是使稳压二极管  $Z_1$  能在比較低的动态阻抗范围内进行工作所必需的电流；最大的輔助电源电流决定于  $Z_1$  在高溫时所容許的最大功率耗散。

电阻  $R_8$  的特性應該使得起始公差和环境影响都不致引起它的电阻超过下列所規定的极限：

$$\frac{E_{a\min}-3.6}{0.035} \geq R_8 \geq \frac{E_{a\max}-3.6}{0.075},$$

式中  $R_8$  以欧姆为单位， $E_a$  为使用方所选择的辅助电源电压。上述不等式考虑了  $E_a$  对其标称值的变化。公式的左边，分子为  $R_8$  上出現的最小电压，分母为辅助电源必須供給的最小电流（安培）。公式的右边，分子为  $R_8$  上出現的最大电压，分母为辅助电源所能供給的最大电流。

輔助电源脉动的降低（輔助电源电压中出現的交流脉动  $e_a$  对輸出电压中出現的最終交流脉动  $e_{0a}$  之比）与  $R_8/rz_1$  成比例，其中  $rz_1$  为  $Z_1$  的动态阻抗。由于  $rz_1$  系通过稳压二极管电流的函数，又因为二极管电流系辅助电源电流  $I_a$  的函数，则脉动的降低值既为  $R_8$  又为  $I_a$  的函数，如图 1-3 所示。在选择辅助电源和  $R_8$  的最終值时应記住这种关系。

电路图中表明了輔助电源对負输出端  $Y$  成回路，但也可对正输出端  $Z$  成回路。如果对正输出端成回路，则对于給定的輔助电流，輔助电源电压必須还要大 6 伏，而且需要一个 50 毫安的最小負載来保証輔助电流回路的路径。

## 2.6 稳压器工作范围极限的确定

在規定有最大絕對值的环境溫度( $65^{\circ}\text{C}$ )和負載电流(4 安培)条件下，要稳压器电路在所有用途中工作是不可能的。因为串联晶体管  $Q_1$  只能耗散有限的功率量，輸入电压、負載电流和环境溫度的上限值实际上都是非独立的变数，而且这些变数中的一个可能必須为其他的变数而牺牲，这一点决定于是什么样的特定应用。所述上限值的数量級决定于晶体三极管  $Q_1$  管壳到周围大气的热阻<sup>④</sup>。低的热阻使每个額定值要按比例高些(直至最大絕對值)，而高的热阻則要求每个額定值要按比例低些。

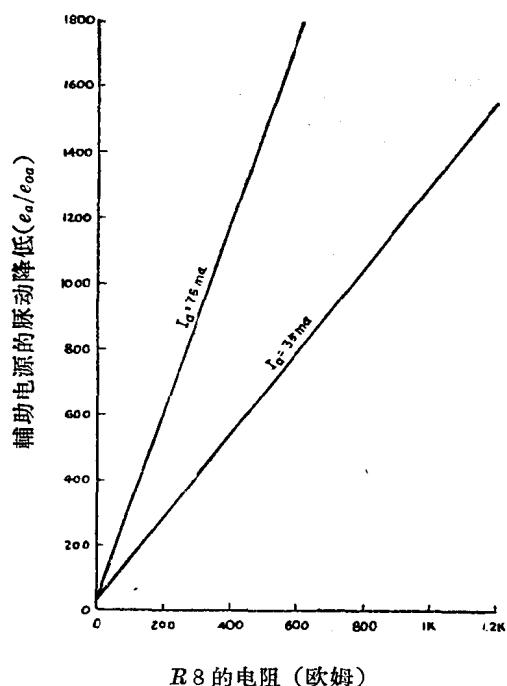


图 1-3 辅助电源脉动的降低与  $R_8$  和辅助电源电流  $I_a$  的关系

为了得到一个比較低的热阻，必須将  $Q_1$  装在散热器上。这样晶体三极管外壳到周围大气的热阻則为晶体三极管外壳到散热器的热阻和散热器到周围大气的热阻之和。有了适合的导热元件和安装压力后，就可以使前一种热阻变得很

④ 热阻定义为一种物质使热量从热势較高的一点（晶体三极管外壳）流到热势較低一点（周围的大气）所表現的阻力，它以热势差（ $^{\circ}\text{C}$ ）对热能流（瓦特）之比來表示。有关热阻的探討可參看 C. Webber 著的“热阻決定了在集电极結所消耗的功率的安全問題”，(Electronic Design, Volumn 8, Number 21, October 12, 1960, pp. 52, 53)。

小。这样需要考虑的主要問題則为散热器到周围大气的热阻問題<sup>⑤</sup>。

图 1—4 中的这四个变数，最大輸入电压，最大負載电流，最大环境溫度和 Q 1 管壳对周围大气的热阻的相互关系是供使用方的。图中表明了电压和电流的极限在环境溫度为 65°C, 55°C 和 45°C 时与热阻的关系。图 1—4 (a) 作为一个例子表明：如果最大輸入电压为 8.7 伏，则 Q 1 外壳到周围大气的热阻必須为 0.5°C/W 以便使电路能在負載电流最大絕對值为 4 安培和环境溫度額定值为 65°C 的条件下工作。

虽然发射极輸送器 Q 2 耗散的功率比之串联晶体三极管 Q 1 要小得多，它也必须装在散热器上。但如果 Q 2 的外壳到周围空气的热阻为 Q 1 热阻的 5 倍，则 Q 2 的耗散极限就成了控制因素，而图 1—4 不再适用了。

对負載电流規定的最大絕對值主要是由选择电路 R 3, R 4, R 5 的电压分配量决定，此量在不严重影响电压比下能够改变。流过 Q 1 的負載电流的变化要求 Q 1 的基极电流改变以保持有固定不变的输出电压。Q 1 基极电流的变化是 Q 4 基极电流变化較小的結果（其相对的电流量为各基极間电流放大系数的函数。由于 Q 4 的

⑤ 此量值决定于一系列的因素，包括散热器的尺寸、外形、材料、定向以及通过散热器的空气流量等。前三个因素对商业用散热器來說是预先确定的，因此这种散热器一般总是附有热阻（作为气流和（或）定向的函数）的規范。热阻往往沒有直接地規定，而可能需要从說明在耗散給定的功率时散热器上的温升的图表来确定。希望自己試制散热器或想確定未知散热器热阻的使用方可參看 W. Luft, “半导体器件的散热方法”，(Electronics, Volume 32, Number 24, June 12, 1959, pp. 53—56)。

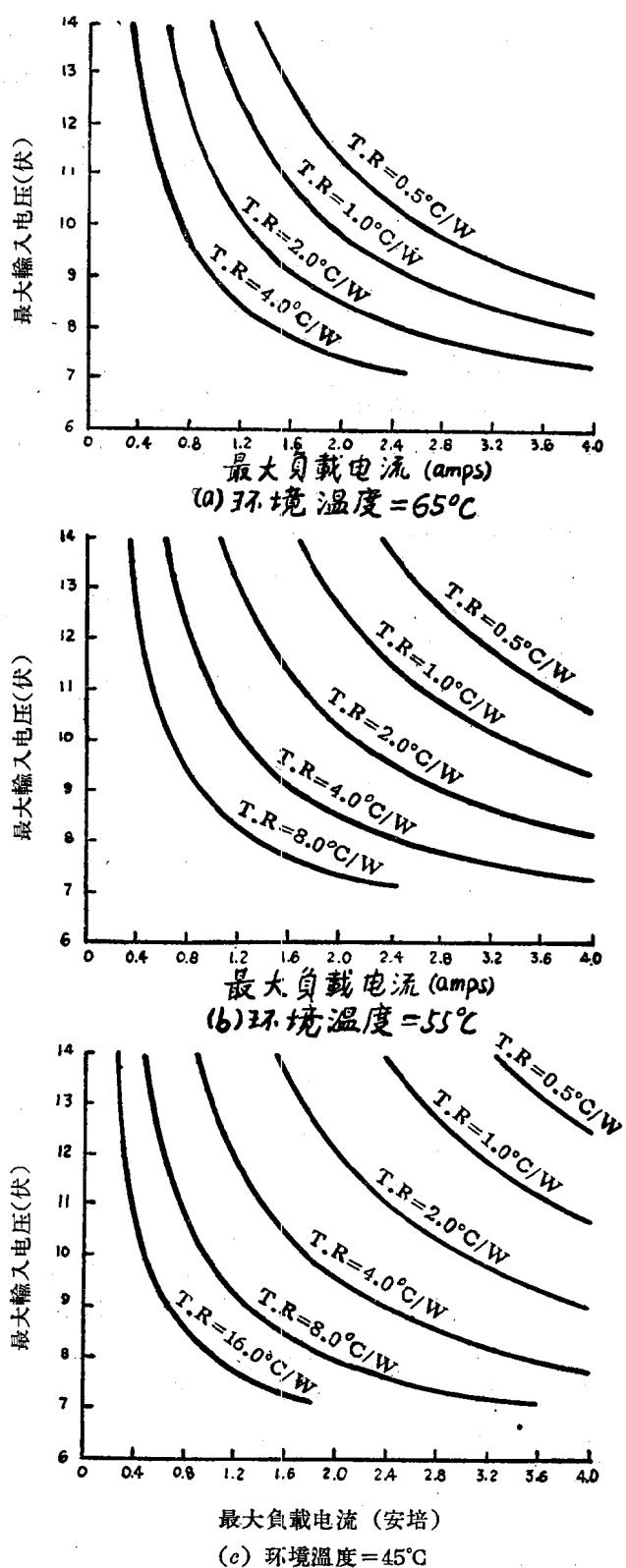


图 1—4 最大輸入电压与最大負載电流的关系（以串联晶体三极管外壳到周围大气的热阻(T.R.)作參变数）。

基极电流負載着选样分压器，又因为  $Q_4$  的輸入电阻是非綫性的， $Q_4$  基极电流的变化就改变了选样电路的电压分配。在規定負荷电流的最大絕對值后， $Q_4$  基极电流的变化則保持在一个不会严重影响上述电压分配的极限。

規定負載电流最大絕對值的其他方法是：(1)加进另一发射极輸送器来增加  $Q_1$  和  $Q_4$  基极間的电流放大系数，或(2)减小选样分压器的总电阻来增加它所取得的标称电流。第一种方法增加了串联控制元件上所需的最小电压降，这种增加是不需要的因为它降低了稳压器的效率。第二种方法是增加灵敏的分压器电阻內所消耗的功率。虽然并联电阻会消除这种缺点，但由于差动放大器的晶体三极管  $Q_4$  和  $Q_5$  的最大功率消耗立即成为限制性因素，则負載电流的增长将是微小的。

稳压器可以进行工作的最大絕對环境溫度主要是决定于差动放大器的晶体三极管中反向电流( $I_{C0}$ )如何考慮的問題。在大約每  $8^{\circ}\text{C}$  溫升时反向电流增加一倍，这样  $Q_4$  和  $Q_5$  的  $I_{C0}$  变化最終将严重地影响到电压的对比。

## 2.7 稳态設計补充考慮的問題

下面几段是以輸入电压和負載电流处在稳态条件为依据的稳压器設計的补充資料。在探討的項目中有： $I_{C0}$  的补偿，輸出电压的調整范围，标准电压的选择和对环境变化的穩定度。

### (a) 发射极輸出器

$Q_2$  和  $Q_3$  是用来作电流放大器，对反饋电路并不进行电压放大。它們的功用是将高輸出阻抗差动放大器  $Q_4$ 、 $Q_5$  的相当低的电流输出进行放大；为串联控制元件  $Q_1$  的低阻抗基极輸入提供足够的激励电流。

电阻  $R_1$  和  $R_2$  分別为  $Q_1$  和  $Q_2$  的  $I_{C0}$  流通提供路径。这样即使在溫度升高时，負載电流降到零也能保証輸出稳压度。如沒供給  $I_{C0}$  流通路径，则在負載电流变成比  $\beta_1 I_{C01}$  或  $\beta_1 \beta_2 - I_{C02}$  小时，稳压将要中止，这里  $\beta_1$ 、 $\beta_2$ 、 $I_{C01}$  和  $I_{C02}$  分別为  $Q_1$  和  $Q_2$  的电流放大系数和集电极-基极反向电流。在室溫或更低的溫度下，当  $I_{C0}$  很小时，可将流經  $R_1$  和  $R_2$  的电流分別加入  $Q_2$  和  $Q_3$  的集电极电流。

为了减少随着溫度而改变的  $I_{C03}$  变化对差动放大器  $Q_4$ 、 $Q_5$  的影响，流經  $Q_3$  的最大  $I_{C0}$  必須小。在电路設計时，如  $Q_3$  用一个有相当低  $I_{C0}$  的低功率晶体三极管，则可得到小的  $I_{C03}$ 。 $Q_3$  的集电极电流是从輔助电源而不是从未經稳压的輸入端供給的，这样  $Q_3$  的电压降，也就是  $Q_3$  必須消耗的功率就可由  $Z_1$  加以限制。这样做也防止  $Q_3$  飽和，因之使串联控制元件上的最小电压降能有較低的值。

### (b) 比較电路

图 1—5 內示出了已稳压的輸出电压和标准（的輸出电压）进行比較的一般方法。图中晶体三极管  $Q_A$  的基极-发射极电压  $V_{be}$  等于选样分压器电压  $V_s$  和标准电压  $V_r$  之差。已稳压的輸出的任一变化都反应为  $V_s$  的变化从而也反应为  $V_{be}$  的变化。 $V_{be}$  的变化由  $Q_A$  放大并送至串联控制元件。这种做法的缺点是：(1)基极-发射极电压降可能会随着溫度而改变，(2)标准电压可能会由于  $Q_A$  集电极电流的变化而改变。在理想情况下經過标准元件的电流應該是无任何变化。

PSC 1 內使用差动放大器作为比較电路来减少图 1—5 所示的电路缺点。此放大器中的一个晶体三极管的基极-发射极电压随着溫度的变化有抵消另一个晶体三极管內类似的变化的傾向。将标准元件  $Z_2$  放置在  $Q_5$  的基极电路內，这样比位在发射极电路內遇到的电流变化要小得多。

在任何一个比較电路內，还要考慮的問題是晶体三极管內集电极-基极反向电流  $I_{C0}$  随着溫度的增加。在图 1—5 所示的电路內， $I_{C0}$  的任何增大将改变选样分压器的电压分配，从而也改变了  $Q_A$  基极上的电压  $V_s$ ，因此已稳压的输出就有了錯誤的指示。在 PSG 1 內，将电阻  $R_9$  加进  $Q_5$  的基极引綫中，这样由于  $Q_4$  集电极基极反向电流的增大而在  $Q_4$  基极产生的电压变化有被  $Q_5$  基极上的类似的电压变化(由于通过  $R_9$  的  $Q_5$  集电极-基极反向电流的增大而引起)抵消的傾向。

### (c) 标准元件

标准元件  $Z_2$  和选样分压器电阻  $R_3$ 、 $R_4$  和  $R_5$  的稳定性主要是决定 稳压器随时间と环境变化而改变的稳定度。本电路采用有低溫度系数和低动态阻抗的稳压二极管作为标准元件。因为  $Z_2$  所取得的电流比  $Q_5$  的最大基极电流大好多倍，基极电流变化不会影响标准电压。电阻  $R_{10}$  应溫度稳定以保証有固定不变的标准电流。 $R_{10}$  的起始公差并不如它对环境变化的最終稳定度来得重要。

标准电压的选择主要是决定于有着所要求性能的稳压二极管的应用。参考二极管(温度补偿的稳压二极管)在电压低于

6 伏时是不可应用的。各种低压的稳压二极管都是可以使用的，但因这些器件的性质，对于工作电压在 5 与 6 伏之間的器件其溫度系数是最低的。对于工作电压超过或低于上述数值的器件則其溫度系数逐渐增加。在理想的情况，标准电压应等于已稳压的输出电压，这样，就消除了选样分压器所引起的反馈电路內的增益损失<sup>⑥</sup>。但是，差动放大器晶体三极管  $Q_4$  和  $Q_5$  必須有一个有限的电极-基极电压以便能正确地起作用。为此，选用了一个 5.1 伏的稳压二极管作为标准元件。

### (d) 选择分压器

已稳压的输出电压对于选样分压器电阻  $R_3$ 、 $R_4$  和  $R_5$  的任何变化都是敏感的。这些电阻的起始公差并不如它对环境变化的最終稳定度来得重要。應該采用功率額定值十分穩當的电阻，并保証这些电阻的比率保持相对地不变， $R_3$  和  $R_5$  的功率額定值与实际的功率耗散应保持在同一比率。

电位器  $R_4$  內所需的调节范围主要是决定于标准元件所容許的工作电压公差，然而，为了包括  $R_3$  和  $R_5$  的起始公差，还要求一些附加范围。由于  $R_3$  和  $R_5$  采用 1% 的起始公差的电阻，所需的調整范围减到最小，这样就确保输出电压易于調至 6 伏并防止了失調增大。

## 2.8 动态設計考慮的問題

一个理想的稳压器內，輸出电压对输入电压或負載电流变化的稳压度应与頻率无关。但在实际上的稳压器內，情况就不是这样。由于 PSG1 所用晶体三极管頻率的限制，在頻率超

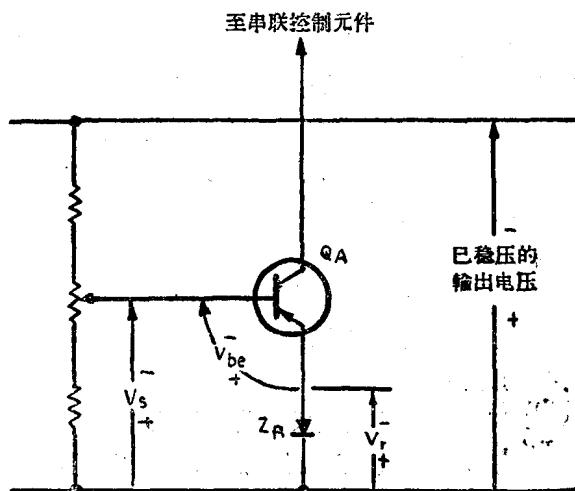


图 1-5 简单的比較电路

⑥ C. A. Franklin, P. M. Thompson 和 W. M. Caton, op. Cit.

⑦ 在用比較电路前，已稳压的输出电压的任何变化被减小約  $V_{Z2}/E_0$  倍，这里  $V_{Z2}$  为标准电压。上述的这种减小也表示为选样分压器  $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$  的函数，但这种結果由于电位器  $R_4$  而不必要地复杂化了。

过5千周时，负反馈电路开始对输出电压失去控制。在频率超过60千周时，输出电压变化的减小主要是决定于输出电容器 $C_1$ ；但频率在5KC和60KC之间时，对输出电压的控制是负反馈电路和输出电容器合成的作用。

本优选电路内对 $C_1$ 采用足够大的电容，这样在负反馈电路开始失去控制的频率范围内它就有低的阻抗。在频率超过5KC时，电容器 $C_1$ 开始使送至差动放大器Q4、Q5的信号减小，这样在上述频率时反馈电路中出现的相位移就不能引起振荡。

让 $C_1$ 使用一个50微法的值来防止由不规则瞬变而产生的减幅振荡就够了。但防止振荡和减小因输入电压或负载电流的突变而产生的瞬时突峰，则必须用一个甚大的并具有低串联电阻的电容器。采用较高频率的晶体三极管可以使 $C_1$ 所用的值较小，但这类锗晶体三极管并没有所需的功率额定值。稳压器的任何不稳定倾向可在Q4集电极到基极间加进一频率选择的负反馈来进一步地加以减小，但在一般情况下并不需要这样做。在上述情况中采用约0.02微法的电容和1千欧的电阻串联起来，以牺牲较低的中频增益和增加的瞬态恢复时间来减少相位移的不稳定性。

电容器 $C_1$ 必须用钽式电容器以便能在低温条件下工作。至于任何其他电解式电容器，由于在低温下串联电阻增大，引起的视在电容的降低是非常大的。

## 2.9 机械结构

PSC1在结构上应采用某些措施以保证最好的性能。机械结构将影响到对负载变化的稳态稳压度，而且也可能是决定瞬态稳压特性的一个主要因素。

由于最大的负载电流很高，必须注意使沿正和负输出汇流条的接触电阻和引线电阻保持在最小值。当选择分压器 $R_3$ 、 $R_4$ 、 $R_5$ 和输出汇流条之间的物理接触在稳压器输出端形成时，则得到对负载变化的最大稳态稳压度。为了在负载上得到大约相同的稳压度，输出端和负载间的引线电阻必须保持为最小值。

当稳压器和负载之间在物理上不可能有小的引线电阻时，则用间接连接法(remote sensing)也能在负载上得到对负载电流变化的最大的稳态稳压度。稳压器内的电线连接必须改

换用图1-6所示的那样的连接。图中所示的两对终端( $Y, Z$ 和 $Y', Z'$ )于是用分开的引线接至负载。电压 $E'_0$ 实质上是直接出现在负载上的电压。由于大的负载电流通过稳压器输出端 $Y, Z$ 和负载之间的有限引线电阻时所产生的电压降， $E'_0$ 比之稳压器的输出电压 $E_0$ 要小些。这时差动放大器即能辨别和校正直接在负载上的电压 $E'_0$ 的变化而不是稳压管输出端的电压 $E_0$ 的变化。

当输出电容器 $C_1$ 和选择分压器连接至稳压器输出端时，以及当电容器的引线保持尽可能短时，就得到最佳的瞬态稳压度。这样就减小了引线电感，这种电感在高频率时升高稳压器的输出阻抗并在输入电压或负载电流突变时附带引起大的电压突

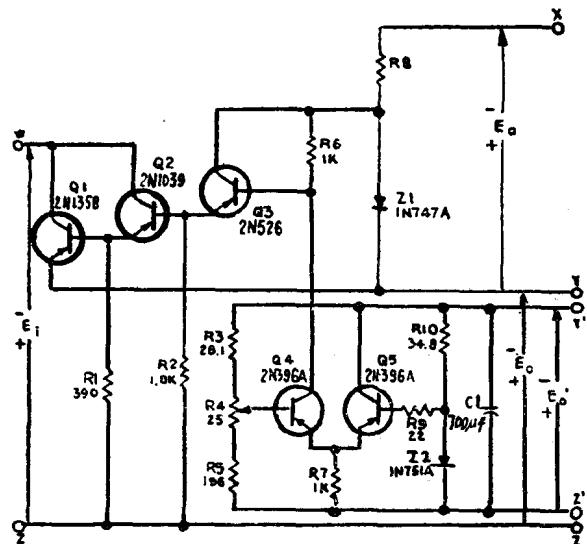


图 1-6 PSC1输出端间接连接法。(Connections for remote Sensing)